

Омский научный семинар

Институт радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН
Омский научно-исследовательский институт приборостроения
Омское отделение Российского научно-технического общества
радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова
кафедра общей и экспериментальной физики ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

«Современные проблемы радиофизики и радиотехники» <http://радиосеминар.рф>

Информационное письмо

В субботу **30 марта 2024 г.**, в **11:30** по адресу пр. Мира 55а, 1 корпус ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ауд. **№ 301** состоится очередное сто шестьдесят шестое заседание Омского научного семинара «Современные проблемы радиофизики и радиотехники». Для дистанционного участия, подключение по ссылке (с указанием ФИО): <https://meet.google.com/xxs-cgpj-zea>

Приглашаем принять участие. Будут заслушаны следующие доклады:

Секция «Перспективные технологии в производстве РЭА»

Никита Максимович Коротков, магистрант ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Влияние облучения мощным ионным пучком на композиционный материал САП-2.

Проведены исследования влияния воздействия мощного ионного пучка наносекундной длительности на фазовый состав и морфологию композиционного материала САП-2. Показано, что увеличение плотности ионного тока приводит к возрастанию доли кислорода на поверхности САП-2, что, по-видимому, связано с частичным испарением алюминия. Обнаруженное уменьшение плотности дислокаций при отжиге привело к уменьшению микротвердости САП-2, облученных с плотностью тока 50 и 100 А/см².

Ксения Алексеевна Жувакина, магистрант ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Исследованию синтеза сверхпроводящей керамики SmBCO”.

Доклад посвящен исследованию синтеза сверхпроводящей керамики SmBCO. Проведен эксперимент по синтезу SmBCO керамики. По результатам найден режим отжига, при котором получается качественная поликристаллическая керамика с высокой критической температурой перехода T_c.

Николай Сергеевич Счастлиных, инженер-технолог 2 категории, АО «ЦКБА»

Технологии изготовления интерпозера

Доклад посвящен ключевым вопросам изготовления интерпозера – специальной коммутационной платы для объединения полупроводниковых кристаллов сложных функциональных устройств в 2D-2,5D сборку. Приведены основные технологические операции двух процессов изготовления интерпозера на кремнии и на стекле. Особое внимание уделено формированию межслойных соединений.

Основными целями научного семинара являются:

- создание благоприятной среды для обмена опытом;
- обсуждение новых идей и подходов в радиофизике и радиотехнике;
- привлечение молодых специалистов к научной и преподавательской деятельности в области радиофизики и радиотехники.

Работа семинара организована по следующим **предметным секциям**:

- «Радиофизическое зондирование»;
- «Антенно-фидерные устройства»;
- «Моделирование процессов и устройств»;
- «Цифровая обработка сигналов»;
- «Разработка, конструирование и производство аппаратуры»;
- «Техника СВЧ»
- «Перспективные технологии в производстве РЭА»
- «Инженерная археология»

Регламент: Доклад – до 15 мин., вопросы – до 10 мин., обсуждение – до 25 минут.

Участники и докладчики:

- Студенты, магистранты и аспиранты ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ, Омавиат и других вузов и сузов.
- Научные сотрудники ИРФЭ ОНЦ СО РАН и других учреждений науки.
- Преподаватели и научные сотрудники ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, ОмГТУ, ОмГУПС, СибАДИ, Омавиат и других вузов и сузов.
- Специалисты и научные сотрудники радиоэлектронных предприятий.

По всем вопросам участия в семинаре и тематике его проведения вы можете обратиться непосредственно к руководителю семинара — Кривальцевичу С.В.

Руководитель семинара – Кривальцевич Сергей Викторович
т., 8-913-665-57-47, 8-904-322-37-34 e-mail: kriser2002@mail.ru

Расположение корпусов ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

